

第二届全国半导体物理学术会议简讯

第二届全国半导体物理学术会议于1979年11月8日至14日在安徽省合肥市召开。出席这次会议的有领导机关、研究单位、高等院校、情报出版、工厂等74个单位的135名代表。11月8日上午,由中国物理学会常务理事、中国科学院半导体所所长黄昆主持开幕式。安徽省委第一书记万里,省委书记顾卓新应邀出席了大会,并作了亲切的讲话。安徽省科委、科协的领导也应邀参加了会议。正在中国科技大学讲学的美籍学者任之恭教授应邀出席了会议。应邀来我国访问的美籍学者范绪筠教授也参加了会议,并作了两次学术报告。

大会共收到学术报告93篇,其中在大会上宣读了19篇,在基础物理、材料物理和器件物理等三个分组会上报告了61篇,书面交流的论文13篇。报告涉及的内容包括半导体中的深能级、无定形半导体、能带计算、半导体表面、半导体中的杂质与缺陷、固溶体半导体和窄禁带半导体等。器件物理方面包括半导体微波器件、激光器件及器件工艺中的许多物理问题。一些评述性的报告,介绍了当前国际上研究工作较为活跃的几个领域中进展情况。

代表们认为这次会议的论文水平较以前有较大提高。在无定形半导体、半导体中的深能级和能带计算等方面的一些报告,跟上了当前国际上的研究步伐。这次会议取得如此可喜的成绩是令人鼓舞的。但与国际先进水平相比,差距还是很大。目前我国半导体物理工作面还不够广,研究的问题有些也比较老,有些领域甚至还是空白。代表们认为,尽管目前还有很多困难,只要认准方向,齐心协力,扎扎实实地做好工作,坚持下去,就一定会把我国半导体物理工作更好地开展起来,跟上国际上前进的步伐。

代表们还座谈讨论了今后如何加速开展半导体物理的研究工作。认为应进一步活跃学术气氛,加强学术交流,经常举办学术报告会,暑期专题讨论会;应大力加强协作;应逐步建立一些现代化的实验室,同时应充分利用能有的各种仪器、设备;对一些比较薄弱的和目前尚未开展的领域应尽快开展起来。

与会代表认为这次会开得好,建议第三届全国半导体物理学术会议于1981年举行。

(陈维德)

NEWS IN BRIEF—SECOND NATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS OF SEMICONDUCTORS

Hefei, Anhui, Nov. 8—14, 1979